

Gujarat Technological University
Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination

Subject Code: C322401

Date: 03/06/2016

Subject Name: Basic Electronic Circuits

Time: 10.30 AM TO 12:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumption wherever necessary.
3. Each question is of 1 mark.
4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed)
5. English version is authentic.

No.	Question Text and Option. પ્રશ્ન અને વિકલ્પો.			
1.	In insulators, the energy gap between valence and conduction bands is			
	A. very large	B. zero	C. very small	D. none of the above
1.	ઇંસ્યુલેટર માં વેલેસ અને કંડક્ષન બેંડ વચ્ચે નો એનજી રોપ.....હોય			
	A. ધાર્થો મોટો	B. શુન્ય	C. ધાર્થો નાનો	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
2.	In a semiconductor, the energy gap between valence and conduction bands is about			
	A. 15 eV	B. 100 eV	C. 50 eV	D. 1 eV
2.	સેમીકંડક્ટર માં વેલેસ અને કંડક્ષન બેંડ વચ્ચે નો એનજી રોપ.....હોય			
	A. 15 eV	B. 100 eV	C. 50 eV	D. 1 eV
3.	The electrons in the conduction band are known as			
	A. bound electrons	B. valence electrons	C. free electrons	D. none of the above
3.	કંડક્ષન બેંડ માં ઇલેક્ટ્રોન.....તરીકે ઓળખાય.			
	A. બાઉંડ ઇલેક્ટ્રોન	B. વેલેસ ઇલેક્ટ્રોન	C. ફી ઇલેક્ટ્રોન	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
4.	The most commonly used semiconductor is			
	A. Germanium	B. Silicon	C. Carbon	D. Sulphur
4.	મોટા ભાગે ઉપયોગ માં આવતું સેમીકંડક્ટરછે.			
	A. જર્મેનીયમ	B. સિલીકોન	C. કાર્బન	D. સલ્ફર
5.	When a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it becomes			
	A. an insulator	B. an intrinsic semiconductor	C. <i>p</i> -type semiconductor	D. <i>n</i> -type semiconductor
5.	જ્યારે પેટાવેલન્ટ અશુદ્ધી ને શુદ્ધ સેમીકંડક્ટર માં ઉમેરવા માં આવે ત્યારે તેબને.			
	A. ઇંસ્યુલેટર	B. ઇંટ્રીસીક સેમીકંડક્ટર	C. પી ટાઇપ સેમીકંડક્ટર	D. એન ટાઇપ સેમીકંડક્ટર
6.	A pentavalent impurity has valence electrons.			
	A. 3	B. 5	C. 4	D. 6
6.	પેટાવેલન્ટ અશુદ્ધી માંવેલેસ ઇલેક્ટ્રોન હોય.			
	A. 3	B. 4	C. 8	D. 5
7.	Addition of trivalent impurity to a semiconductor creates many			
	A. holes	B. free electrons	C. valence electrons	D. bound electrons

	ટ્રાઇવેલ્ટ અશુદ્ધી એ ઘણા બધાઉત્પન્ન કરે છે.			
9.	A. હોલ્સ	B. ફી ઇલેક્ટ્રોન		
	C. વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન	D. બોડ ઇલેક્ટ્રોન		
8.	As the doping to a pure semiconductor increases, the bulk resistance of the semiconductor			
	A. remains the same	B. Increases		
	C. Decreases	D. none of the above		
	જ્યારે શુદ્ધ સેમીકડકર નુ ડોપિંગ વધારવામા આવે ત્યારે તેનો બલક રેઝિસ્ટરન્સ			
6.	A. સરખો જ રહે	B. વધે		
	C. ધર્ટે	D. આમાં થી એક પણ નહીં.		
9.	In a semiconductor, current conduction is due			
	A. only to holes	B. only to free electrons		
	C. to holes and free electrons	D. none of the above		
	સેમીકડકર માં કરંટ નુ વહન,ના કારણે થાય.			
6.	A. ફક્ત હોલ	B. ફક્ત ફી ઇલેક્ટ્રોન		
	C. હોલ અને ફી ઇલેક્ટ્રોન	D. આમાં થી એક પણ નહીં.		
10.	A forward biased <i>pn</i> junction has a resistance of the			
	A. order of Ω	B. order of $k\Omega$		
	C. order of $M\Omega$	D. none of the above		
10.	ફોરવર્ડ બાયસ પીએન જંક્શન માં અવરોધ ની કિંમત.....માં હોય.			
	A. Ω	B. $k\Omega$		
	C. $M\Omega$	D. આમાં થી એક પણ નહીં.		
11.	The barrier voltage at a <i>pn</i> junction for germanium is about			
	A. 33v	B. 3V		
	C. 0.3v	D. 0.7v		
11.	જમોનીયમ ના પીએન જંક્શન માટે નો બેરીયર ની કિંમતહોય			
	A. 33v	B. 3V		
	C. 0.3v	D. 0.7v		
12.	The leakage current across a <i>pn</i> junction is due to			
	A. minority carriers	B. majority carriers		
	C. junction capacitance	D. none of the above		
12.	પીએન જંક્શન નો લીકેજ કરંટ એના કારણે હોય.			
	A. માઇનોરિટી કેરીયર	B. મેજોરિટી કેરીયર		
	C. જંક્શન કેપેસીટિસ	D. આમાં થી એક પણ નહીં.		
13.	With forward bias to a <i>pn</i> junction, the width of depletion layer			
	A. decreases	B. Increases		
	C. remains the same	D. none of the above		
13.	જ્યારે પીએન જંક્શન ને ફોરવર્ડ બાયસ કરવા મા આવે ત્યારે ડેપ્લેશન લેયર ની પહોળાય....			
	A. ધર્ટે	B. વધે		
	C. સરખોજ રહે	D. આમાં થી એક પણ નહીં.		
14.	In an intrinsic semiconductor, the number of free electrons			
	A. equals the number of holes	B. is greater than the number of holes		
	C. is less than the number of holes	D. none of the above		
14.	ઇન્ટ્રિન્સીક સેમીકડકર માં ફી ઇલેક્ટ્રોન ની સંખ્યા.....			
	A. હોલ જટલી જ હોય.	B. હોલ કરતા વધુ હોય.		
	C. હોલ કરતા ઓછી હોય.	D. આમાં થી એક પણ નહીં.		
15.	The forward voltage drop across a silicon diode is about			
	A. 0.7V	B. 1.2V		
	C. 0.3V	D. 12V		
15.	સીલ્વિકોન ડાયોડ માં ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ ડ્રોપ ની કિંમત....			
	A. 0.7V	B. 1.2V		
	C. 0.3V	D. 12V		
16.	A diode utilises characteristic for rectification.			

	A.	reverse	B.	Forward
	C.	forward or reverse	D.	none of the above
16.		ડાયોડ રેક્ટિફિકેશન નીલાક્ષણીકતા નો ઉપયોગ કરે.		
	A.	રીવર્સ	B.	ફોરવર્ડ
	C.	ફોરવર્ડ અથવા રિવર્સ	D.	આમાં થી એક પણ નહીં.
17.		If the doping level in a diode is increased, the width of depletion layer		
	A.	remains the same	B.	is decreased
	C.	is increased	D.	none of the above
18.		જો ડાયોડ નું ડોપિંગ લેવલ વધારવા માં આવે તો તેના ડેપ્લેશન લેયર ની પહોળાય		
	A.	સરખી જ રહે	B.	ઘટે
	C.	વધે	D.	આમાં થી એક પણ નહીં.
19.		A zener diode has		
	A.	one <i>pn</i> junction	B.	two <i>pn</i> junctions
	C.	three <i>pn</i> junctions	D.	none of the above
20.		અનર ડાયોડ ને હોય		
	A.	એક જંક્શન	B.	બે જંક્શન
	C.	ત્રણ જંક્શન	D.	આમાં થી એક પણ નહીં.
21.		A zener diode is used as		
	A.	an amplifier	B.	a voltage regulator
	C.	a rectifier	D.	a multivibrator
22.		અનર ડાયોડ નો ઉપયોગ ...માં થાય.		
	A.	એમ્પલીફાયર	B.	વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર
	C.	રેક્ટિફાયર	D.	મલ્ટીવાયબ્લેન્ડર
23.		A zener diode is always connected.		
	A.	Reverse	B.	Forward
	C.	either reverse or forward	D.	none of the above
24.		અનર ડાયોડ હંમેશામા જોડાય.		
	A.	રીવર્સ	B.	ફોરવર્ડ
	C.	રીવર્સ કે ફોરવર્ડ	D.	આમાં થી એક પણ નહીં.
25.		A zener diode utilises characteristic for its operation.		
	A.	Reverse	B.	Forward
	C.	either reverse or forward	D.	none of the above
26.		અનર ડાયોડ તેના ઓપરેશન માટેલાક્ષણીકતા નો ઉપયોગ કરે.		
	A.	રીવર્સ	B.	ફોરવર્ડ
	C.	રીવર્સ કે ફોરવર્ડ	D.	આમાં થી એક પણ નહીં.
27.		The disadvantage of a half-wave rectifier is that the		
	A.	components are expensive	B.	diodes must have a higher power rating
	C.	output is difficult to filter	D.	none of the above
28.		હાલ્ફ વેવ રેક્ટિફાયર નો ગેરફાયર્દો એ..... છે.		
	A.	કમ્પોનેટ મોંધા છે.	B.	ડાયોડ
	C.	આઉટપુટ ને ફિલ્ટર કરવું અધકુ છે.	D.	આમાં થી એક પણ નહીં.
29.		If the A.C. input to a half-wave rectifier has an R.M.S. value of $400/\sqrt{2}$ volts, then diode PIV rating is		
	A.	$400/\sqrt{2}V$	B.	$400 * \sqrt{2}V$
	C.	400V	D.	none of the above
30.		જો $400/\sqrt{2}$ વોલ્ટ R.M.S. એ.સી. ઇનપુટ એ હાલ્ફ વેવ રેક્ટિફાયર ને આપીએ તો ડાયોડ ના PIV રેટિંગ ્યેવા જોઇએ.</td <td></td> <td></td>		
	A.	$400/\sqrt{2}V$	B.	$400 * \sqrt{2}V$
	C.	400V	D.	આમાં થી એક પણ નહીં.
31.		The ripple factor of a half-wave rectifier is		
	A.	2	B.	1.21

	C.	2.5	D.	0.48
24.	હાલ્ફ વેવ રેક્ટિફિયર નો રીપલ ફેક્ટરહોય.			
	A.	2	B.	1.21
25.	The PIV rating of each diode in a bridge rectifier is that of the equivalent centre tap rectifier.			
	A.	one-half	B.	the same as
26.	બ્રિજ રેક્ટિફિયર ના દરેક ડાયોડ ના PIV સેટીંગ એ સેંટર ટેપ રેક્ટિફિયર કરતાહોય.			
	A.	અડધા	B.	સરમા
27.	There is a need of transformer for			
	A.	half-wave rectifier	B.	centre-tap full-wave rectifier
28.	ટ્રાંસફોર્મર ની જરૂરમાં હોય			
	A.	હાલ્ફ વેવ રેક્ટિફિયર	B.	સેંટર ટેપ કુલ વેવ રેક્ટિફિયર
29.	C.			
	A.	કુલ વેવ બ્રિજ રેક્ટિફિયર.	B.	આમાં થી એક પણ નહીં.
30.	The maximum efficiency of a half-wave rectifier is			
	A.	40.6%	B.	81.2%
31.	C.			
	A.	50%	B.	25%
32.	હાલ્ફવેવ રેક્ટિફિયર ની મહત્વમાં કાર્યક્ષમતા.....હોય.			
	A.	40.6%	B.	81.2%
33.	C.			
	A.	50%	B.	25%
34.	The capacitance of a varactor diode increases when reverse voltage across it			
	A.	decreases	B.	Increases
35.	C.			
	A.	breaks down	B.	stores charge
36.	વેરેક્ટર ડાયોડ નો કેપેસીટેસ વધે જ્યારે રેવર્સ ડાયોડ ને રીવર્સ વોલ્ટેજ નેઆવે.			
	A.	ઘટાડવામાં	B.	વધારવામાં
37.	C.			
	A.	બ્રેક ડાઉન કરવામાં	B.	ચાર્જ ને સ્ટોર કરવામાં આવે.
38.	To display the digit 8 in a seven-segment indicator			
	A.	C must be lighted	B.	G must be off
39.	C.			
	A.	F must be on	B.	All segments must be lighted
40.	સેવન સેગમેન્ટ ડિસ્પ્લે માં 8 ડિસ્પ્લે કરવા માટે.....			
	A.	સી ને પ્રકાશિત કરવો જ પડે	B.	જુ બંધ હોવો જોઈએ.
41.	C.			
	A.	એક ઓન હોવો જ જોઈએ	B.	બધા જ સેગમેન્ટ પ્રકાશિત હોવા જોઈએ.
42.	When the light increases, the reverse current in a photo-diode			
	A.	Increases	B.	Decreases
43.	C.			
	A.	is unaffected	B.	none of the above
44.	જ્યારે પ્રકાશ વધે ત્યારે, ફોટો ડાયોડ નો રીવર્સ કરેટ			
	A.	વધે	B.	ઘટે
45.	C.			
	A.	માં ફેર ના પડે	B.	આમાં થી એક પણ નહીં.
46.	To display the digit 0 in a seven segment display			
	A.	A must be lighted	B.	F must be off
47.	C.			
	A.	G must be on	B.	all segments except G should be lighted
48.	સેવન સેગમેન્ટ ડિસ્પ્લે માં 0 ડિસ્પ્લે કરવા માટે.....			
	A.	એ ને પ્રકાશિત કરવો જ પડે	B.	એક બંધ હોવો જોઈએ.
49.	C.			
	A.	જુ ઓન હોવો જ જોઈએ	B.	જુ સિવાય ના બધા જ સેગમેન્ટ પ્રકાશિત હોવા જોઈએ.
50.	A transistor has			
	A.	one <i>pn</i> junction	B.	two <i>pn</i> junctions
51.	C.			
	A.	three <i>pn</i> junctions	B.	four <i>pn</i> junctions
52.	32. ટ્રાંઝિસ્ટર ને.....			

	A. એક પીએન જંક્શન હોય	B. બે પીએન જંક્શન હોય
	C. ત્રણ પીએન જંક્શન હોય	D. ચાર પીએન જંક્શન હોય
33.	The number of depletion layers in a transistor is	
	A. Four	B. Three
	C. One	D. Two
33.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર માં ડેપ્લેશન લેયર ની સંખ્યા.....હોય	
	A. ચાર	B. ત્રણ
	C. એક	D. બે
34.	The element that has the biggest size in a transistor is	
	A. collector	B. Base
	C. Emitter	D. collector-base junction
34.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર માં સૌથી મોટો ભાગ.....એલીમેન્ટ હોય.	
	A. કલેક્ટર	B. બેઝ
	C. એમિટર	D. કલેક્ટર બેઝ જંક્શન
35.	A transistor is a operated device.	
	A. Current	B. Voltage
	C. both voltage and current	D. none of the above
35.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર એસંચાળીત ડિવાઇસ છે.	
	A. કર્ટ	B. વોલ્ટેજ
	C. કર્ટ અને વોલ્ટેજ બજે	D. આમાં શી એક પણ નહીં.
36.	In an <i>npn</i> transistor, are the minority carriers.	
	A. free electrons	B. Holes
	C. donor ions	D. acceptor ions
35.	<i>Npn</i> ટ્રાન્ઝિસ્ટર માંમાઇનોરિટી કેરીયર હોય છે.	
	A. ફી ઇલેક્ટ્રોન	B. હોલ્સ
	C. ડોનોર આયન	D. અક્સેપ્ટર આયન
37.	The input impedance of a transistor is	
	A. High	B. Low
	C. very high	D. almost zero
37.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર નો ઇનપુટ ઇમ્પ૆ડન્સ.....હોય	
	A. વધુ	B. ઓછો
	C. ઘણો વધુ	D. ઊરો નાણુક
38.	In a transistor,	
	A. $IC = IE + IB$	B. $IB = IC + IE$
	C. $IE = IC - IB$	D. $IE = IC + IB$
38.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર માં.....	
	A. $IC = IE + IB$	B. $IB = IC + IE$
	C. $IE = IC - IB$	D. $IE = IC + IB$
39.	The value of α of a transistor is	
	A. more than 1	B. less than 1
	C. 1	D. none of the above
39.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર માં α ની કિંમત.....હોય	
	A. ૧ કરતાં વધુ	B. ૧ કરતાં ઓછી
	C. ૧	D. આમાં શી એક પણ નહીં.
40.	$IC = \alpha IE +$	
	A. IB	B. $ICEO$
	C. $ICBO$	D. βIB
40.	$IC = \alpha IE +$	
	A. IB	B. $ICEO$
	C. $ICBO$	D. βIB
41.	In a transistor if $\beta = 100$ and collector current is 10 mA, then IE is	
	A. 100 mA	B. 100.1 mA
	C. 110 mA	D. none of the above

41.	જો ટ્રાન્ઝિસ્ટર માં $\beta = 100$ અને કલેક્ટર કરેટ 10 mA હોય તો, IE ની કિંમત			
	A. 100 mA	B. 100.1 mA	C. 110 mA	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
	The value of β for a transistor is generally			
42.	A. 1	B. less than 1	C. between 20 and 500	D. above 500
	ટ્રાન્ઝિસ્ટર માં β ની કિંમત.....હોય			
	A. 1	B. 1 કરતા ઓછી	C. 20 થી 500 ની વચ્ચે	D. 500 કરતા વધુ
43.	The most commonly used transistor arrangement is arrangement.			
	A. common emitter	B. common base	C. common collector	D. none of the above
	મોટે ભાગે ઉપયોગમાં આવતી ટ્રાન્ઝિસ્ટર ની સંરચના.....છે.			
43.	A. ક્રોમન એમીટર	B. ક્રોમન બેઝ	C. ક્રોમન કલેક્ટર	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
	The phase difference between the input and output voltages in a common base arrangement is			
	A. 180°	B. 90°	C. 270°	D. 0°
44.	ક્રોમન બેઝ સંરચના માં ઇનપુટ અને આઉટપુટ વચ્ચે ના વોલ્ટેજનો ફેઝ તફાવતહોય.			
	A. 180°	B. 90°	C. 270°	D. 0°
	ક્રોમન એમીટર સંરચના માં ઇનપુટ અને આઉટપુટ વચ્ચે ના વોલ્ટેજનો ફેઝ તફાવતહોય.			
45.	The phase difference between the input and output voltages of a transistor connected in common emitter arrangement is			
	A. 0°	B. 180°	C. 90°	D. 270°
	ક્રોમન એમીટર સંરચના માં ઇનપુટ અને આઉટપુટ વચ્ચે ના વોલ્ટેજનો ફેઝ તફાવતહોય.			
46.	A. 0°	B. 180°	C. 90°	D. 270°
	The voltage gain of a transistor connected in arrangement is the highest.			
	A. common base	B. common collector	C. common emitter	D. none of the above
47.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર નીજોડાણ રચના માં સૌથી વધુ વોલ્ટેજ ગેઠન મળે.			
	A. ક્રોમન બેઝ	B. ક્રોમન કલેક્ટર	C. ક્રોમન એમીટર	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
	$ICEO = (\dots) ICBO$			
48.	A. B	B. $1+\alpha$	C. $1+\beta$	D. none of the above
	$ICEO = (\dots) ICBO$			
	A. B	B. $1+\alpha$	C. $1+\beta$	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
49.	A heat sink is generally used with a transistor to			
	A. increase the forward current	B. decrease the forward current	C. compensate for excessive doping	D. prevent excessive temperature rise
	ટ્રાન્ઝિસ્ટર સાથે સામાન્ય રીતેમાટે હિટ સિંક ઉપયોગ મા આવે છે.			
50.	A. ફોરવર્ડ કરેટ વધારવા	B. ફોરવર્ડ કરેટ ઘટાડવા	C. વધુ ડોપીંગ ને સપ્રમાણ કરવા	D. તાપમાન ના વધારા ને રોકવા
	The most commonly used semiconductor in the manufacture of a transistor is			
	A. germanium	B. Silicon	C. carbon	D. none of the above
51.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર ને બનાવવા માટે સૌથી વધુ વપરાતુ સેમીકિડક્ટરછે.			
	A. જર્મેનીયમ	B. સીલીકોન	C. કાર્ਬન	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
	ટ્રાન્ઝિસ્ટર ને બનાવવા માટે સૌથી વધુ વપરાતુ સેમીકિડક્ટરછે.			

	If the value of α is 0.9, then value of β is			
50.	A. 9	B. 0.9	C. 900	D. 90
50.	જો α ની કિંમત 0.9 હોય, તો β ની કિંમતથાય.			
50.	A. 9	B. 0.9	C. 900	D. 90
51.	Transistor biasing represents conditions.			
51.	A. A.C.	B. D.C.	C. both A.C. and D.C.	D. none of the above
51.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર નું બાયસિંગશરત બતાવે છે.			
51.	A. A.C.	B. D.C.	C. A.C. અને D.C. બજે	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
52.	Operating point represents			
52.	A. values of IC and VCE when signal is applied	B. the magnitude of signal	C. zero signal values of IC and VCE	D. none of the above
52.	ઓપરેટીંગ પોઇન્ટરજુ કરે છે.			
52.	A. IC અને VCE ની કિંમત જ્યારે સિનલ આપેલું હોય તે	B. સિનલ ની કિંમત	C. IC અને VCE ની ઊરો સિનલ કિંમત	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
53.	Transistor biasing is generally provided by a			
53.	A. biasing circuit	B. bias battery	C. Diode	D. none of the above
53.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર બાયસિંગ મોટાભાગેકારા આપવામાં આવે છે.			
53.	A. બાયસિંગ સરકીટ	B. બાયસ બેટરી	C. ડાયોડ	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
54.	For faithful amplification by a transistor circuit, the value of VBE should for a silicon transistor.			
54.	A. be zero	B. be 0.01 V	C. not fall below 0.7 V	D. be between 0 V and 0.1 V
54.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર ના વ્યવસ્થિત એમાલીફીકેશન માટે VBE ની કિંમત સિલીકોન ટ્રાન્ઝિસ્ટર માટેહોય.			
54.	A. ઊરો	B. 0.01 V	C. 0.7 V કરતા ઓછી નહીં	D. 0 V અને 0.1 V ની વચ્ચે
55.	The point of intersection of d.c. and a.c. load lines represents			
55.	A. operating point	B. current gain	C. voltage gain	D. none of the above
55.	ઓ.સી. અને ડી.સી. લોડ લાઇન નો ક્રોસ પોઇન્ટરજુ કરે.			
55.	A. ઓપરેટીંગ પોઇન્ટ	B. કરટ ગેઇન	C. વૉલ્ટેજ ગેઇન	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
56.	An ideal value of stability factor is			
56.	A. 100	B. 200	C. 10	D. 1
56.	સ્ટેબિલિટી ફેક્ટર ની આદર્શ કિંમતછે.			
56.	A. 100	B. 200	C. 10	D. 1
57.	The disadvantage of base resistor method of transistor biasing is that it			
57.	A. is complicated	B. is sensitive to changes in β	C. provides high stability	D. none of the above
57.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર બાયસિંગ ને બેઝ રેન્ઝિસ્ટર રીતા નો ગેરફાયરો એછે.			
57.	A. ગુચ્છવાખભરી છે.	B. β સાથે સંસીટીવ છે.	C. વધુ સ્ટેબિલિટી આપે	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
58.	The biasing circuit has a stability factor of 50. If due to temperature change, $ICBO$ changes by $1 \mu\text{A}$, then IC will change by			
58.	A. $100 \mu\text{A}$	B. $25 \mu\text{A}$	C. $20 \mu\text{A}$	D. $50 \mu\text{A}$

48.	બાયસીંગ સરકીટ નો સ્ટેબીલિટી ફેકફેર 50 છે. જો તાપમાન ના બદલાવ ને કારણે $ICBO$ $1 \mu A$ જેટલો બદલાય તો, IC જેટલો બદલાય.			
	A. $100 \mu A$	B. $25 \mu A$	C. $20 \mu A$	D. $50 \mu A$
59.	The operating point is also called the			
	A. cut off point	B. quiescent point	C. saturation point	D. none of the above
60.	ઓપરેટીંગ પોઇન્ટ પણ કહેવાય.			
	A. કટઓફ પોઇન્ટ	B. ક્વેશન્ટ પોઇન્ટ	C. સેચ્યુરેશન પોઇન્ટ	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
61.	The disadvantage of voltage divider bias is that it has			
	A. high stability factor	B. low base current	C. many resistors	D. none of the above
62.	વોલ્ટેજ ડિવાયડર સરકીટનો ગેરફાયદો છે.			
	A. ઉચ્ચ સ્ટેબીલિટી ફેકટર	B. ઓછો બેઝ કરેટ	C. ધારણા અવરોધો	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
63.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર સરકીટ દ્વારા યોગ્ય એપ્પલિફિકેશન માટે, ઓપરેટીંગ પોઇન્ટજવાબે ડિસી લોડ લાઇન મા હોવો જોઈએ.			
	A. છેલ્લે	B. મધ્યમાં	C. વધુ મા વધુ કરેટ પોઇન્ટ	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
64.	If the value of collector current IC increases, then value of VCE			
	A. remains the same	B. Decreases	C. Increases	D. none of the above
65.	કલેક્ટર કરેટ IC ની કિંમત વધે તો, VCE ની કિંમત			
	A. સરળી જ રહે.	B. ધરે.	C. વધે.	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
66.	When the temperature changes, the operating point is shifted due to			
	A. change in $ICBO$	B. change in VCC	C. change in the values of circuit resistances	D. none of the above
67.	જ્વારે તાપમાન વધે ત્યારે ઓપરેટીંગ પોઇન્ટના કારણે બદલાય.			
	A. $ICBO$ ના બદલાવ	B. VCC ના બદલાવ	C. સરકીટ અવરોધોના બદલાવ	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
68.	In voltage divider bias, $VCC = 25 V$; $R1 = 10 k\Omega$; $R2 = 2.2 k\Omega$; $RC = 3.6 k\Omega$ and $RE = 1 k\Omega$. What is the emitter voltage ?			
	A. $6.7 V$	B. $5.3 V$	C. $4.9 V$	D. $3.8 V$
69.	વોલ્ટેજ ડિવાયડર બાયસ માટે, $VCC = 25 V$; $R1 = 10 k\Omega$; $R2 = 2.2 k\Omega$; $RC = 3.6 k\Omega$ અને $RE = 1 k\Omega$. તો એમીટર વોલ્ટેજ ની કિંમત કેટલે થાય?			
	A. $6.7 V$	B. $5.3 V$	C. $4.9 V$	D. $3.8 V$
70.	A zener diode is used as a voltage regulating device.			
	A. shunt	B. Series	C. series-shunt	D. none of the above
71.	અનર ડાયડ.....વોલ્ટેજ રેચ્યુલેટીંગ ડિવાઇસ તરીકે ઉપયોગ થાય.			
	A. શાન્ટ	B. સિરીઝ	C. સિરીઝ અને શાન્ટ	D. આમાં થી એક પણ નહીં.
66.	When load current is zero, the zener current will be			

	A. zero	B. Minimum	
	C. maximum	D. none of the above	
56.	લોડ કરણ છિરો હોય ત્યારે એનર કરણ.....હોય		
	A. છિરો	B. ઓછા માં ઓછુ	
	C. વધુ માં વધુ	D. આમાં થી એક પણ નહીં.	
67.	The zener current will be minimum when		
	A. load current is maximum	B. load current is minimum	
	C. load current is zero	D. none of the above	
68.	When an A.C. signal is applied to an amplifier, the operating point moves along		
	A. D.C. load line	B. A.C. load line	
	C. both D.C. and A.C. load lines	D. none of the above	
69.	જ્યારે એમ્પલીફાયર ને એસી સિઝલ આપવામાં આવે ત્યારે ઓપરેટીંગ પોઇન્ટ.....બાજુ જાય.		
	A. ડિસી લોડ લાઇન	B. એસી લોડ લાઇન	
	C. એસી અને ડિસી લોડ લાઇન	D. આમાં થી એક પણ નહીં.	
70.	In the zero signal conditions, a transistor sees load.		
	A. d.c.	B. a.c.	
	C. both d.c. and a.c	D. none of the above	
71.	છિરો સિઝલ કંડીશન માં ટ્રાન્ઝિસ્ટરલોડ અનુભવે.		
	A. ડિસી	B. એસી	
	C. ડિસી અને એસી બંને	D. આમાં થી એક પણ નહીં.	
72.	The input capacitor in an amplifier is the capacitor.		
	A. coupling	B. Bypass	
	C. leakage	D. none of the above	
73.	એમ્પલીફાયર નું ઇનપુટ કેપેસીટર એકેપેસીટર છે.		
	A. કપલીંગ	B. બાયપાસ	
	C. લીકેજ	D. આમાં થી એક પણ નહીં.	
